① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-278740

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)11月15日

H 01 L 21/56 21/60

EQ 3 1 1

6412-5F 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

国発明の名称

半導体装置のパツケージング方法

願 平1-99177 21)特

成

彦

ĖΒ

願 平1(1989)4月19日 220出

@発 明 考 髙 兒. 茂 明 江 達 ⑫発 者 入

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

忽発 明 者 橋 爪

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

@発 明 者 斉 藤 宏 勿出 顖 松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

外2名

個代 理 人 弁理士 竹元 敏丸

#### 1. 発明の名称

半導体装置のパッケージング方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 予めICのポンディングパッドに相対する 位置にパンプを形成したリードフレームに封止枠 を形成し、しかる後、前記リードフレームを支え ていたダイバーを切断すると共に端子をフォーミ ングして封止枠付リードフレームを形成し、該封 止枠付リードフレームにICチップを接合し、該 ICチップを樹脂封止してなる半導体装置のパッ ケージング方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

本発明は、半導体装置のパッケージング方法に 関する。

## 〔従来の技術〕

通常、ICチップをリードフレームに取りつけ るに際しては、ICチップとリードフレーム間は ワイヤーボンディングされるか、チップ上に形成 された接続用突起電極(パンプ)を介して接続さ

ワイヤーボンディングでICチップを実装する 場合、ICのI/O数(ピン数)が増した場合、 例えば、10㎜角200ピンのICの場合、チッ プ上のポンディングパッドの間隔は200 **㎜**以下 となり、ワイヤリング時のツール(キャピラリー )とワイヤーの接触する限界値に迫り、これ以上 は不可能である。

また、ポンディング時間においても、ワイヤー ポンディング方式では、1ワイヤー当たり約 0.2 秒必要とし、200ワイヤーの場合、40秒のボ ンディング時間を要する。

これに対し、バンプを介して接続する方式は、 一括して接合するため、ボンディング時間が2秒 程度となり、大幅に短縮化が図れるが、チップ上 にパンプを形成する為(バンプを形成するには通 常のAL電極上に拡散防止の金属層の形成や接合 の改善を図る接着層の形成が必要である)、コス トアップ、歩留まりの低下につながるといった問 J. .

題があった。

### (発明が解決しようとする課題)

本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、多ピン化への対応が図れると共に、ボンディング時間の短縮化が図れ、しかもコストアップにつながらない半導体装置のハッケーシング方法を提供することにある。

# 〔課題を解決するための手段〕

上記課題を解決するため本発明は、予め「Cのボンディングパッドに相対する位置にバンプを形成したリードフレームに封止枠を形成し、しかる後、前記リードフレームを支えていたダイバーを切断すると共に端子をフォーミングして封止枠付リードフレームを形成し、該封止枠付リードフレームに「Cチップを接合し、該「Cチップを樹脂封止してなることを特徴とする。

#### (実施例)

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。第 1図(a)~(d)は本発明の一実施例を示す工程図であ

とせず、ワイヤーボンディングされるのと同様の 仕様 (A ℓ パッド) のままで良いので、コストダ ウンが図れる。さらにまた、リードフレーム 1 に は封止枠 3 が成形されているので、後工程での封 止が容易になる。

なお、上記実施例では封止枠3をモールドで形成したが、プリント板を形成するように積層して 形成してもよい。

#### (発明の効果)

本発明は上記のように、 I C チップとリードフレームの接合時間の短縮化が図れると共に、多ピン対応が可能となり、また、従来のワイヤーボンディング用の I C をそのまま用いて一括ボンディングできるので、汎用性がありコストダウンが図れる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(d)は本発明の一実施例を示す工程図である。

1…リードフレーム

2 … パンプ

る。まず、リードフレーム1の適所、すなわち! Cのポンディングパッドに相対する位置にバンプ2を形成する(同図(a)参照)。バンプ2は、Au等の1 C電極材料(Aℓ)と接合性の良い材料で形成する。次に、上記リードフレーム1に封止枠3をモールド成形する(同図(c)参照)。しかる切り、リードフレーム1を支えていたダイバーを切り、は3をモールド成形する(同図(c)参照)。このように構成された封止枠付リードフレーム4に1 Cチップ5を接合し、ポッティング等の方法により【Cチップ5を樹脂封止し、【Cの保護を行なう(同図(d)参照)。

これにより、従来例の如きワイヤーボンディングのパッド間隔の制限は取り除かれ、リードフレームの加工限界まで可能となる。また、ボンディング時間はパッド数に関係なく一定(2秒程度)となり、工程の効率化が図れる。さらに、リードフレーム1にパンプ2を形成するため、パンプ2の材料を適切に選択すれば(上記実施例のようにAuを用いれば)、ウエハーの特別な加工は必要

3 … 封止枠

4 - 対止枠付りードフレーム

5…ICチップ

### 特許出顧人

松下電工株式会社 代理人 弁理士 竹元敏丸 (ほか2名)

第1図

